INK JET HEAD

Publication number: JP60038163 (A) 1985-02-27

Publication date:

IWASAKI KIYUUHACHIROU; YAMAMURO SATORU

Inventor(s): Applicant(s):

RICOH KK

Classification:

- international:

B41J2/045; B41J2/055; B41J2/16; B41J2/045; B41J2/055; B41J2/16; (IPC1-

7): B41J3/04

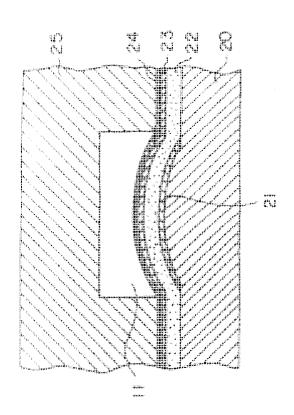
- European:

B41J2/16D; B41J2/16M1; B41J2/16M3

Application number: JP19830146867 19830811 Priority number(s): JP19830146867 19830811

Abstract of JP 60038163 (A)

PURPOSE:To obtain an ink jet head having a piezoelectric polymer as a press element, by providing a plurality of conductive layers on a base plate comprising a non-conductive material and covering the base plate and the conductive layer with three layers of a piezoelectric polymer layer, a separate conductive layer and a protective layer. CONSTITUTION: A base plate 20 is formed of a nonconductive material and a plurality of conductive layers Ei (i=1, 2, ...n) on the base plate. A piezoelectric filn 22 comprising PVDF is adhered to said conductive layers and a conductive layer Eg 23 is formed by the vapor deposition of a conductive material and a protective layer 24 having ink resistance is further formed.; An ink flowline forming body 25 is brought into contact with said protetive layer 24 so that ink pressurizing chamber 11 comes to the position corresponding to each conductive layer Ei 21 and the conductive layer Eg is used as a common electrode to respectively independently apply an electric signal to the conductive layers Ei.



Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

昭60-38163 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

60Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

紹公開 昭和60年(1985)2月27日

B 41 J 3/04

103

7810-2C

審査請求 未請求 発明の数 2 (全14頁)

❷発明の名称

インクジェットヘッド

②特 願 昭58-146867

20出 願 昭58(1983)8月11日

72発 明 者 饱発 明 者 岩崎 山 室

久八郎 哲 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

株式会社リコー ⑪出 願 人

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

弁理士 高野 明近 60代 理 人

1. 発明の名称

インクジェツトヘツド

- 2.特許請求の範囲
- (1). 振動業子として圧電性高分子を用いたインク ジェットヘッドにおいて、
 - (a) 非遵循材料からなる基板と、
 - (b) 該基板上に形成された複数個の導電層 E i $(i = 1, 2, \dots n) \ge$.
 - (c) 該基板と前記複数個の導電層を覆うごとく 一体的に形成された圧電性高分子層と、
 - (d) 該圧電性高分子層を覆うごとく一体的に形 成された導電層Egと、
 - (e) 該導電層Egを覆うごとく一体的に形成さ れた保護層と、
 - (f) 前記複数個の導電層Eiに対応する位置に インク加圧室を形成し、該インク加圧室の 一端にインク噴射ノズル部を、他端にイン ク供給部形成するがごとく、前記保護層上 に当接されたインク流路形成体と、

からなり、前記導電層Egを共通電極とし、前記 導電層Eiに各々独立に電気信号を印加するよう にしたことを特徴とするインクジェットヘッド。 (2).前記非導能材料からなる基板の前記導電層 E i部に対応する部分を薄い支持基板としたことを 特徴とする特許請求の範囲第(1) 項に記載のイン クジエットヘッド.

- (3).前記非導電材料から成る基板の前記導電層 E i 部に対応する部分を、一部空洞又は全面空洞と したことを特徴とする特許請求の範囲第(1) 項に 記載のインクジェットヘッド。
- (4). 振動素子として圧電性高分子を用いたインク ジェットヘッドにおいて、
 - (a) 非導電材料からなる基板と、
 - (b) 該基板上に一体的に形成された第1の導電 層 E g と、
 - (c) 該第1の導電層Egを覆うごとく一体的に 形成された第1の圧電性高分子層と、
 - (d) 該圧電性高分子層上に形成された複数個の 導電器 Ei (i=1,2,…n)と、

- (e) 前記圧電性高分子層と前記複数個の電極を 覆うごとく一体的に形成された第2の圧電 性高分子層と、
- (f) 該第2の圧電性高分子層を覆うごとく一体 的に形成された第2の導電層 E g と、
- (g) 該第2の導電層Egを覆うごとく一体的に 形成された保護層と、
- (h) 前記複数の導電層Eiに対応する位置にインク加圧室を形成し、該インク加圧室の一端にインク噴射ノズル部を、他端にインク供給部を形成するがごとく、前記保護層上に当接されたインク流路形成体と、

からなり、前記導電層EBを共通電極とし、前記 導電層Eiに各々独立に電気信号を印加するよう にしたことを特徴とするインクジェットヘッド。 (5).前記非導電材料からなる基板の前記導電層E i 部に対応する部分を稼い支持基板としたことを 特徴とする特許請求の範囲第(4) 項に記載のイン クジェットヘッド。

(6).前記非導電材料から成る基板の前記導電層 E

- (a). 可続性があり曲面加工性がよい。
- (b). 薄膜化・大面積化が容易である。
- (c).軽い。

などのすぐれた特徴をもつている。

これに対して、無機圧電体は闘く、力学的変化

i 部に対応する部分を、一部空胸又は全面空制と したことを特徴とする特許請求の範囲第(4) 項に 記載のインクジェットヘッド。

3 . 発明の詳細な説明

技術分野

木発明は、インク室のインクを加圧してインク 滴を噴射するインクジェットヘッド、より詳細に は、インク室のインクを加圧する加圧素子として、 圧電性高分子を用いたインクジェットヘッドに関 する。

従来技術

インクジェット記録装置は周知であり、そのためのインクジェットに録装置は周知であまされたでおり、たたまのに、セラミック電歪素子のは、たけなかのに、セラミック電であるが、こので変素が、なった。では、アンク加圧部の面積が戻すがあった。そのでででは、アンクルによるインクジェットへ、アンは、破界の作用を利用したインクジェットへ、アンは、破界の作用を利用したインクジェットへ、アンは、成りによるインクジェットである。

に脆い。

目 的

本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされた もので、特に、インクジェットヘッドに圧電性高 分子を効果的に用いて、低電圧で駆動できる大規 模集積化可能で、かつ量産性に優れたインクジェ ットヘッドを提供することを目的としてなされた ものである。

梢 成

木発明の構成について、以下、実施例に基づいて説明する。

実施例1

この実施例は、インク室のインクを加圧してインク滴を噴射するインクジェットヘッドにおいて、加圧来子に圧電性高分子例えばポリフッ化ビニリデン(PVDF)を用いたマルチノズルインクジェットを実現したものである。

最初に、上記圧電性高分子を用いたインクジェットへツドの動作原理について第1図を参照しながら説明する。

第1図において、1はインク室、2はインク加圧来子、3はインク摘で、インク室1内のインクを加圧してインク摘を噴射させるには、インクを加圧したときの実効変位量がインク滴の体積にこの射させた場合、Vo=4/3・π(70/2)ュ(μm²)に略等しい実効変位量がポットへでは、かかる実効変位量を得ることが健となるので、ここにその変位量について算出する。

第1図において、〇、〇AおよびABはそれぞれ、PVDFを摘曲させたときの曲率中心、曲半径および弦を変わす。また〇から弦ABに垂線を下したとき、その底をHとし、直線OHと弧ABとの交点をPとする。この消曲した厚さしの圧電性配で数dsiの効果を、縦方向すなわち声の(=PQ(=△R)」に変換することができる。変形前の形が半径Rの円弧で、変形後に二次

曲線になるとすると、中心部の変位 P Q (= Δ R)

$$\triangle R = \frac{3}{2} R d \cdot 1 \cdot \frac{V}{t} \cdots \cdots \cdots (1)$$

で与えられる。本実施例は、この電圧駆動による ムRの変位を利用して、インクを加圧し、インク 摘を噴射させるものである。

(1) 式は、円弧の張る角をαとしたとき、9.
 75°≤α<90°の範囲で成立する。ここで、d₃₁=40PC/Nとし、t=20μmのPV

DFフイルムを用いると、

を得る。(2) 式より、大きな変位 \triangle R を得るには、大きな曲率半径をもつた摘曲がよいことがわかる。 しかるに、曲率半径 R は、R = (a / 2) / s i n (α / 2) であるから、ここに R の最大値は、 α = 9 . 75° のとき、すなわち、

$$R = (a/2) / s i n 4 . 8 7 5 ° ... (3)$$

となる。

$$= \frac{4}{3} \pi \times (\frac{70}{2})^{-3} (\mu m^{3}) \cdots (4)$$

なる関係が実現したときに、インクが噴出する。

実効変位量 Δ V eff を算出するにあたっては、まず変位面積 Δ S の算出が必要なので、それから計算することにする。ここでわかりやすくするため、第 3 図のように曲率中心を順点とした(X , Y) 座標を考える。この座標より、二次曲線 A Q B と円弧 A P B とを求め、そこから変位面積 Δ S を求めると、

$$\triangle S = \frac{a}{3} (3 R + 2 \triangle R - b)$$

$$- R^{2} \left\{ \frac{\pi}{2} + \frac{a}{2 R} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{2 R}\right)^{2} - \cos^{-1} \left(\frac{a}{2 R}\right)} \right\}$$
... (5)

が求められる。

$$\triangle S = \frac{a}{6} \left\{ 4 \left(R + \triangle R \right) - R \sqrt{1 - \left(\frac{a}{2 R} \right)^2} \right\}$$

$$- R^2 \left\{ \frac{\pi}{2} - \cos^{-1} \left(\frac{a}{2 R} \right) \right\} \cdots (8)$$

を得る。 △ S を求めるためには、 a と R と △ R の 値が必要である。 弦 の長さ a を 与えると、 (3) 式より R が求まり、 それによつて (2) 式より △ R が 選圧の関数として求まる。 斯様にして、 与え

特開昭60-38163 (4)

数の長さaを、a=170 μmとすると、(3) 式より、

R = (170/2)/sin4.875°=1 000・210μm,また、(2)式より、

 $\triangle R (\mu m) = 3 .00063 \times 10^{-3} V (v$

となり、これらを(6)式に代入すると、

 \triangle S = (3.401 × 1 0 4 V - 0.198) μ m 2 となる。これを(4)式に代入して、

 η l (3.401×10 - V - 0.198) = 179600 (μ m³)

なるインク加圧時のインク噴射条件を得る。ここで、印加電圧 V を V = 5 0 Vaitとすると、前記 n l は、 n l = 1 0 . 6 9 mmとなる。なお、この効率 n と 長さl の関係は表 1 に示す通りである。た

ぞれの値を示すが、斯様にして、湾曲した PVDFを電圧駆動することによつてインクを加圧すると、インク滴を噴射することができる。 なお、厚さ t を小さくすると、印加電圧 V をそれだけ低くすることができる。

だし表 1 において、 a = 170 μm. V = 50 Volt. d 3 1 = 40 P C / N. t = 20 μm である。なお、この場合、初期の曲率半径R は 1 .00 mm であり、印加電圧 50 Voltをかけたときの中心部の変位 Δ R は 0 . 150 μm である。

表 1

n (%)	Q (mm)
100	1 0 . 7
5 0	21.4
25	42.7

第4図乃至第8図は、種々の弦の長さaに対する効率 n と 長さ l の 積 n l の 関係を、各印 m 電圧に対してプロットしたもので、各図とも d 2 1 = 40 P C / N、 t = 20 μ m である。また、 表 2 には、 種々の弦の長さa、 曲率半径 R、 弦と円弧の中心間の長さb、 及び印加電圧 V に対する中心部の変位 c R 及び 効率 n と 長さ l の 積 n l の それ

表 2

a	R (mm)	b (μm)	V (valt)	△R (μm)	ηΩ
70 µm	0.41	1.49	200	0.25	15.6
			100	0.12	31.3 m
170 дв	1.00	3.62	100	0.30	5.3 #
		50	0.15	10.7 m	
230 μm 1.35 4.	4.90	75	0.30	3.9 m	
			50	0.20	5.8
340 µm	2.00	7.24	30	0.18	4.5 m
			20	0.12	6.7 m
			10	0.06	13.9 a
400 µm	2.35	8.51	30	0.21	3.2 m
			20	0.14	4.9 m
			10	0.07	10.0 m
500 µm	500 μm 2.94 10	10.6	30	0.26	2.1
			20	0.18	3.1 m
			10	0.09	6.4 m
1.0mm	5.88	21.3	20	0.35	0.78 m
			10	0.18	1.6 🛭
			5	0.09	3.3 в
5.0mm	29.4	106	20	1.77	31 μα
			10	0.88	64 µm
			5	0.44	134 με
7.5mm	44.1	160	10	1.32	28 µm
			5	0.88	59 µm
10.0mm	58.8	213	10	1.77	16 μ π
			5	0.88	33 μ π
20.000	118	426	10	3.53	4 μπ
	5		5	1.77	8 µm

第9図は、PVDFを用いてマルチノズルのイ ンクジェットヘッドを構成する場合の一個を説明 するための図、さきに示した第2図は、第9図の D 部の詳細図に相当する。図中、11はインク加 圧室、12はインク噴射ノズル、13はインク供 給部で、この例は、図示のように、PVDFの横 振動方向すなわち第2図に示したAB方向をマル チノズルの並び方向と同じにするようにしたもの である。すなわち、高解像度の印字をおこなうマ ルチノズルのインクジェツトでは、インク流れに 垂底方向のインク加圧室の幅を大きくとれず、た とえば、8ドツト/==の解像度をもつインクジェ ツトでは、一次元アレイのマルチノズルの場合は 約70μmの幅、ちどり状アレイのマルチノズル の場合は約170μmの幅、また四段配列のマル チノズルの場合は、約400μmの幅しかとれな い。このような微細加工を伴なうインク加圧室に おいては、第9図に示されるように、圧電性高分 子の伸縮方向がマルチノズルの並び方向と同じと なるように設置しなければならない。

第10図は、上述のごときインクジェットヘッドの一製造方法の一例を説明するための要部構成図、第11図は第10図のD部の詳細図で、図中、20は塔板、21は導電層、22はPVDF層。23は導電層、24は保護層、25はインク流路形成体で、該インクジェットヘッドは、例えば以下のようにして製作される。

- ① ガラス、樹脂等の非導電材料で基板 2 0 を形成する。
- ② 該基板上に電板E i 形成部、リード線形成部を 残し、フォトレジスト等でマスキングを行なう。
- ③ A 2 等の導電材を蒸着し、電板E i (導電層) 2 1 およびリード線 (図示せず)を形成する。
- ④ 一軸低温延伸し分極処理を施こして得たPVD Fの圧電性フイルムを接着して、圧電性のPV DF増22を形成する。
- ⑤ A 2 等の導電材を蒸着等して導電層 2 3 を形成する。
- ⑤ S i O₂ , S i₂ N₃ 等耐インク性のある物質でC V D 法等により保護層 2 4 を形成する。

③ 感光性ガラスにエツチングでノズル、インク加圧室、インク供給部等を形成したインク流路形成体25を各インク加圧室が各導電層Eiに対応する位置に機械的または接着等化学的手段により当接する。

第12図は他の製造方法を説明するための図で、 (a)図は分解図、(b)図は組立工程図で、この場合は以下のようにして製作する。

- ①ガラス、樹脂等の非導電材料で通気孔をもつた 支持基版30を形成する。
- ③ 導電器 3 2 上に S i O 2 , S i 2 N 3 等耐イン ク性のある物質で C V D 法等により保護器 3 3 を形成して 3 4 を形成する。
- ④ 該保護層34をフラットな支持基板35上にきつちりと盛りつめる。
- ⑤感光性ガラスにエツチングでノズル、インク加

圧室、インク供給部等を形成したインク流路形成体36に、前記保護層34を接着する。

- ®フラットな支持基板35をはずし、全面電極3 2の反対側のPVDF上に各インク加圧室に対応する電極形成部及びリード線形成部を残こし、メタルマスク等でマスキングを行なう。
- ⑦ A 2 等の導電材を蒸着し、電標Ei(導電層) 3 7 及びリード線(図示せず)を形成する。
- 動支持基板30を、その湾曲部が各導電層Ei (各インク加圧室に対応)に対応する位置に設 超し、圧電性フィルム31の各導電層Ei間と 基板30の各湾曲部間とを機械的または接着等 化学的手段により当接する。

以上、上記インクジェットヘッドによれば、電標層、PVDF層、電極層、保護層の全てを一体加工することができるので、最産性に優れたインクジェットヘッドを提供することができる。

実施例2

この実施例は、インク室のインクを加圧してインク稿を噴射するインクジェットヘッドにおいて、

加圧素子に圧電性高分子、例えば、ポリフツ化ビニリデン(PVDF)を用い、該圧電性高分子をバイモルフ構造としたインクジェットヘッドを実現したものである。

圧電性高分子膜は、膜面に垂直に印加した電場により面内の一方向へ伸縮する。この振動は微小な変位だが、バイモルフ構造をとることにより10 4 倍程度に拡大し得る。本実施例は、この圧電性高分子バイモルフの非常に大きい振幅をインクジェットヘッドに応用したものである。

最初に、上記パイモルフ構造のインクジェット ヘッドの動作原理について第13図を参照しなが ら説明する。

第13図において、1はインク室、2′はインク加圧案子(バイモルフ圧電性高分子)、3はインク摘で、インク室1内のインクを加圧してインク減を噴射させるには、インクを加圧したときの実効変位量がインク摘の体積に略等しくなければならない。すなわち、今ここに約50μm×50μmのノズルからインク稿を噴射させた場合、前

近 ひょ ノド

$$V \circ = \frac{4}{3} \pi \times (\frac{70}{2})^2 (\mu m^3)$$
 に略等しい実
効変位 最が要求されることになる。このように、
この実 施例においても、かかる実効変位量を得る
ことが鍵となるので、ここにその変位量について
貸出する。

第13図において、O、OAおよびABはそれでれ、バイモルフが海曲したときの曲率中弦ABにおいなをあらわす。また、Oから弦ABに延録を下したとき、その底をHとし、直線のHEを印加すると、一方が縮み他方が伸びるる。例えてでは9μmの厚さのポリファにである。CPVDF)膜を2枚貼り合わせてもこと、一の場合について考える。このボモンに電圧を印加すると、一

方が縮み他方が伸びるので、一方の端を固定すると、他の自由端は曲がりにより変位し、その曲率半径Rの逆数と印加電圧Vとの関係は、V=0のときの初期曲率を無限大(完全に水平)とすれば、

で与えられる。

上述の様に、本発明は、電圧駆動によるインク室 凸の曲率変化を利用してインクを加圧し、インク摘 を噴射させるものである。

ここで、実効変位量 △ Veff は、A P B H A で朋まれた 変位 面積 △ S と、 第 1 4 図のように 清曲 したときの P V D F フイルムの弦 A B に対する 垂直 方向の 長さ 2 と、インク を噴射させるときの 実効効率 7 との積、すなわち、 △ Veff = n・△ S ・ 2 であらわせる。従つて

なる関係が実現したときに、インクが噴射する。

実効変位量 △ V eff を算出するにあたつては、まず、変位面積 △ S の算出が必要なのでそれを計算することにする。ここでわかりやすくするため、第 1 5 図のように、曲率中心を原点とした(x , Y) 座標を考える。今パイモルフの中立線である 弧 A B 長さを c , 弦 A B の長さを a 、また、 精曲の中心部の変位 P H の長さを b とすれば、

$$\triangle S = R^{2} \left\{ \frac{\pi}{2} - \frac{a}{2R} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{2R}\right)^{2}} - c \circ s^{-1} \left(\frac{a}{2R}\right)^{2} \right\} \cdots \cdots (8)$$

$$\hbar \stackrel{\mathcal{L}}{\leftarrow} L, \quad a = 2R s i n \left(\frac{c}{2R}\right)$$

$$b = R \left\{ 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{a}{2R}\right)^{2}} \right\} \cdots (10)$$

$$(0 < b < R)$$

特開昭60-38163 (フ)

である。従つて、上記式(7)、(8)、(10)より、一定の中立線の長さとをもつたバイモルフに駆動電程 Vをかければ、弦ABの長さa、そして変位面積 ムSが求まる。次に、このムSを(8) 式に代入して、ここにバイモルフの特定の中立線の長さとと駆動電圧 V に対するインク加圧時のインク噴射条件を、カ、2の関係として決定できる。

例えば、 c = 1 7 0 μm , 1 0 0 Voit の場合、 効率 7 と長さ 2 との関係は 3 に示すと おりである。 このとき、変化したときのバイモルフの弦の 長さは、 a = 169.889 μm であり、これは中立線 の長さ 1 7 0 μm に対し、わずか 0.001 μm 短縮 しただけであり、 A , B 端は固定してよい。 また、 バイモルフの中心部の変位は b = 0.21 μm である。

表 3

η (%)	A (mm)
1 0 0	7.47
3 0	14.9

第16図乃至第19図は、厚さ9μmのPVD F膜を2枚貼り合わせたバイモルフの種々の中立線の長さcと、効率ηと長さ2の積η2を、各印加電圧に対してプロットしたものである。

表もは、前記パイモルフPVDFの種々の中立 線の長さcと印加電圧Vに対する、曲率半径R、 中心部の変位b、弦の長さa、および、効率 n と 長さlとの積っlの値を、それぞれリストしたも のであるが、この表からもcとaとはほとんどか わらず、従つて、パイモルフの両端をきつちり固 定してよいことがわかる。

≵ 4

sy •					
c	V (volt)	R (=)	b (дв)	a	ηl
70 µ∎	200	8.52	0.07	69.9998 µm	53.5 mm
90 μ m	200	8.52	0.12	89.9996 µm	25.2 mm
120 да	200	8.52	0.21	119.9990 μm	10.8 mm
140 µm	200	8.52	0.29	139.9984 дв	6.7 mm
	100	17.0	0.14	139.9996 дв	13.3 mm
170 μπ	100	17.0	0.21	169.9993 μm	7.5 mm
	50	34.1	0.11	169.9898 μm	14.9 mm
190 дв	100	17.0	0.26	189.9990 μm	5.4 mm
	75	22.7	0.20	189.9995 μm	7.1 mm
	50	34.1	0.13	188.9998 μm	10.7 mm
200 µ∎	75	22.7	0.22	199.9994 μm	8.1.mm
	50	34.1	0.15	199.9998 μm	9.1 mm
400 μm	50	34. 1	0.59	399.9977 μm	1.15mm
	20	85. 1	0.23	399.99963 μm	2.87mm
	10	170	0.12	399.99891 μm	5.73mm
500 µ∎	50	34.1	0.92	499.9955 μm	0.59mm
	10	170	0.18	499.9998 μm	2.9 mm
	5	341	0.09	499.99995 μm	5.9 mm
1.0	10	170	0.73	999.9986 μm	367 μm
	5	341	0.38	999.9986 μm	734 μm
2.0	10	170	2.93	1.99989 mm	46 μm
	5	341	1.47	1.999897 mm	92 μm
2.200	10	170	3.55	2.199985 mm	34 μm
	5	341	1.77	2.199996 mm	89 μm
2.5mm	10	170	4.59	2.499978 mm.	23 μm
	5	341	2.29	2.499994 mm	47 μm

第20図は、前記パイモルフ圧電性高分子を用 いてマルチノズルのインクジェットヘッドを構成 した場合の一部切断斜視図で、図中、11はイン ク加圧室、12はインク噴射ノズル、13はイン ク供給部を示すが、この場合は、第20図に示す 圧電性高分子の横振動方向すなわち第21図(第 20図D部詳細図:第14図と同じ) に示される A B 方向をマルチノズルの並び方向と同じにする。 第22図は、上記パイモルフインクジェットへ ッドの製造方法の一例を説明するための要部断面 図で、(a) 図は分解部、(b) 図は組立図で以 下のように製作する。図中、40は基板、41及 び 4 5 は溥電層、 4 2 はPVDF層、 4 3 は電極 Ei暦、46は保護暦、48はインク流路形成体 で、酸インクジェツトヘツドは、例えば、次のよ うにして製作される。

- ① ガラス、 樹脂等の、 非導電材料で 悲椒 4 0 を形成する。
- ② A. 2 等の導電材を蒸着等により導電器 4.1 を形成する。

- ④ 被 P V D F 層 4 2 上に電板 E i 形成部、リード 線形成部を残し、メタルマスク等でマスキング を行なう。
- (5) A 2 等の導電材を蒸着し、電極E i (導電層)4 3 およびリード線(図示せず)を形成して、4 4 を形成する。
- ⑤ PVDFの圧電性フィルム42の片面の全面に A2等の導電材を真空蒸着により導電層45を 形成する。
- (力 該導電層 4 5 上に S i O 2 , S i 2 N 3 等耐 インク性のある物質で、C V D 法等により保護層 4 6 を形成して 4 7 を形成する。
- 御 燃光性ガラスにエツチングでノズル、インク加 圧室、インク供給部等を形成したインク流路形 成体 4 8 に、該 4 7 を接着する。
- 99 インク流路形成体 4 8 の各インク加圧室が 4 4 の各導電層 B i に対応する位置に機械的、また

- は接着等化学的手段により当接する。
- 第23図は、他の製造方法を説明するための図で、(a) 図は分解図、(b) 図は組立工程図で、この場合は、以下のようにして製作する。
- ① 一軸低温延伸をし、分極処理を施こした PVD F圧電性フィルム 5 2 の片面の全面に A 2 等の 導電性材料を真空蒸着し、導電層 5 1 を形成して5 3 を形成する。
- ② P V D F 圧 電性フイルム 5 2 の片面に A 2 等の 再電材を真空蒸着して再電層 5 4 を形成する。
 次に再電層 5 4 上に S i O 2 、 S i 2 N 3 等耐イン ク性の ある物質で C V D 法等により保護層 5 5 を形成して 5 6 を形成する。
- (3) 感光性ガラスにエツチングでノズル、インク加 圧室、インク供給部等を形成したインク流路形 成体 5 7 を形成し、それに上記 5 6 を接着する。
- ④ 該56の全面電極54と反対側のPVDF上に 各インク加圧室に対応する電極形成部及びリー ド線形成部を残こし、メタルマスク等でマスキングを行なう。

- 5 A 2 等の導電材を蒸着し、電極 E; (導電層) 5 8 及びリード線 (図示せず)を形成する。
- (6) 被 5 6 上に 上記 5 3 をエピコート等の 樹脂で 接着し、マルチのバイモルフ構造を形成する。

以上に、本発明の各実施例について説明したが、 上記各実施例で、 電極を支持基板上に蒸着する製 造方法のものは、 電極が支持基板に接合されてい るので、 印加電圧によつて圧電性高分子が変化する際の負荷が非常に大きい。以下に示す例は上述 のごとき負荷を軽減するようにしたもので、 各例 は、 前記実施例 1 を改良した形で記載されている が、 当然のことながら、実施例 2 にも適用できる ものである。

例 1

この例は、第24図及び第25図に示すように(ただし、第25図は第24図のD部の詳細図)、将電層21に対応する基板部分を薄い基板61とすることにより、PVDF層22が上下に振動する際の負荷を軽減できるようにしたもので、これによつて、①変位効率があがり、そのため②振動

部の面積低減を計ることができてより高密化が可能となり、また、面積をそのままに固定した場合には、③駆動電圧の低減をすることができ、駆動回路の小型化が可能となるものである。

以下に、その製造方法の一例について説明する。 ①ガラス、樹脂等の、非導電材料で基板 2 0 を形成する。

- ② 該基板上に電板 E i 形成部、リード線形成部を 残し、フォトレジスト等でマスキングを行なう。
- ③ A 2 等の導電材を蒸着し、電極 E i (導電層) 2 1 及びリード線 (図示せず)を形成する。
- ④一軸低温延伸し分極処理を施こして得たPVD Fの圧電性フイルムを接着して、圧電性のPV DF層22を形成する。
- ⑤ A 2 等の 導電材を 蒸着等により導電器 2 3 を形成する。
- ⑤ S i O₂ , S i N₃ 等耐インク性のある物質で C V D 法等により、保護層 2 4 を形成する。
- ⑦前記基板20に、各導電層Bi部に対応するパターニングをしてエッチングにより、確い支持

基板部 6 1 を形成する。(この瘻い支持基板部 6 1 の厚さは、エッチング時間を制御することにより形成される。

即感光性ガラスによりエツチングでノズル、インク加圧室、インク供給部等を形成したインク流路形成体25を各インク加圧室が各導電層Eiに対応する位置に機械的または接着等化学的手段により当接する。

例 2

この例は、第26図及び第27図に示すように(ただし、第27図は第26図のD部詳細図)、専電暦21に対応する一部を空網にしたり、或いは、第28図及び第29図に示すように(ただし、第29図は第28図のD部詳細図)、専電暦21に対応する全部を空網にしたもので、これによりで、圧電性高分子(PVDF)層が上下に振動する際の負荷を軽減できるようにし、これにより変し、場合の表があがり、そのため、①振動部の面積低減を計ることができて、より高密化が可能となり、また、②面積を固定した場合は、駆動電圧の低減

を計ることができ、駆動回路の小型化が可能となるものである。

以下に、その製造方法の一例について説明する。 ① ガラス、樹脂等の、非森電材料で碁板20を形成する。

- ② 該基板上に電極 E i 形成部、リード線形成部を 残し、フォトレジスト等でマスキングを行なう。
- ③ A 2 の導電材を蒸着し、電極Ei (導電層) 2 1 及びリード線 (図示せず)を形成する。
- 一軸低温延伸し分極処理を施こして得たPVD Fの圧電性フイルムを接着して、圧電性のPV DF層22を形成する。
- (5) A & の導電材を蒸済等により導電層 2 3 を形成する。
- ⑤ Sì O₂ , Si N₃ 等耐インク性のある物質で C V D 法等により、保護暦 2 4 を形成する。
- ⑦ 基板 2 0 に前記導電暦 2 1 に対応する一部分又は全面に空制部のパターニングをしてエッチングにより一部分空調部(通気孔)6 2 又は全面空制部6 3 を形成する。(なお、その際、基板

と導 世層とはエッチング液が異なるよう材料を 選択することにより、エッチングは導電層まで 進行した時点で停止され、一部分空嗣(通気孔) 6 2 または全面空洞 6 3 が形成される。

8) 燃光性ガラスにエッチングでノズル、インク加 圧室、インク供給部等を形成したインク流路形 成体25を各インク加圧室が各導電層Eiに対 応する位置に、機械的まだは接着等化学的手段 により当接する。

匆 果

以上の説明から明らかなように、本発明によると、電極層、圧電性高分子(PVDF)層、電極層、保護層の全てを一体的に微細加工できるので、量産性に優れ、かつ、低電圧で駆動可能な大規模集積化可能なインクジェットヘッドを提供することができる。また、本発明においては、保護層は上電性高分子の片面にのみ設ければよいので、その分製造工程を被らすことができる。

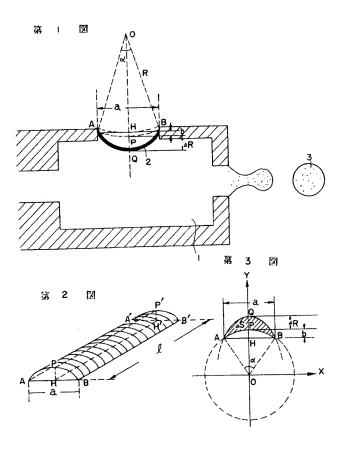
4. 図面の簡単な説明

第1 図乃至第12 図は、本発明の第1の実施例

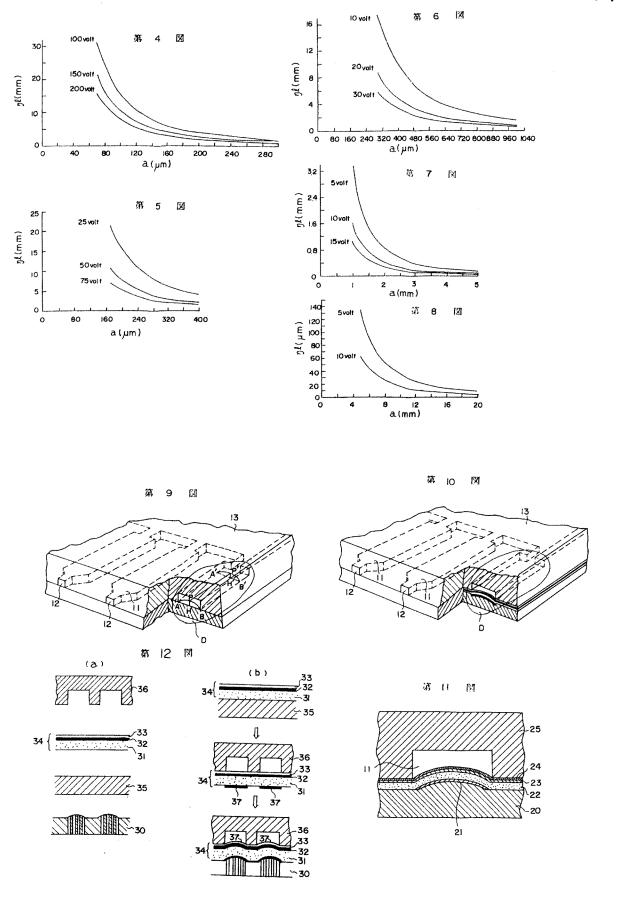
を説明するための図で、第1図は、インクジェッ トヘッドの要部断面図、第2図及び第3図は、木 実施例の動作原理を説明するための線図、第4日 乃至第8図は、それぞれ、弦の長さaに対する効 率ηと長さえの関係を印加電圧に対してプロット した図、第9図は、本実施例をマルチノズル化し た場合の要部斜視図、第10図は、本事施例によ るインクジェットヘッドの製造方法の一個を説明 するための要部斜視図、第11図は、第10図の D 部詳細図、第12図もまた、本実施例によりイ ンクジェットヘッドの製造方法を説明するための 図、第13図乃至第23図は、本発明の他の実施 例を説明するための図で、第13図は、本実施例 を説明するための要部断面図、第14図及び第1 5 図は、本実施例の動作原理を説明するための線 図、第16図乃至第19図は種々の中立線の長さ cと効率のと長さえの積かえの関係を各印加電圧 に対しプロットした図、第20図は本実施例をマ ルチノズル化した場合の要部斜視図、第21図は、 第20図のD部詳細図、第22図及び第23図は、 それぞれ本実施例によりインクジェットへッドの製造方法を説明するための図、第24図、第26図、28図は、それぞれ前記両実施例の改良例を示す図で、第25図は、第24図のD部詳細図、第29は、第28図のD部詳細図である。

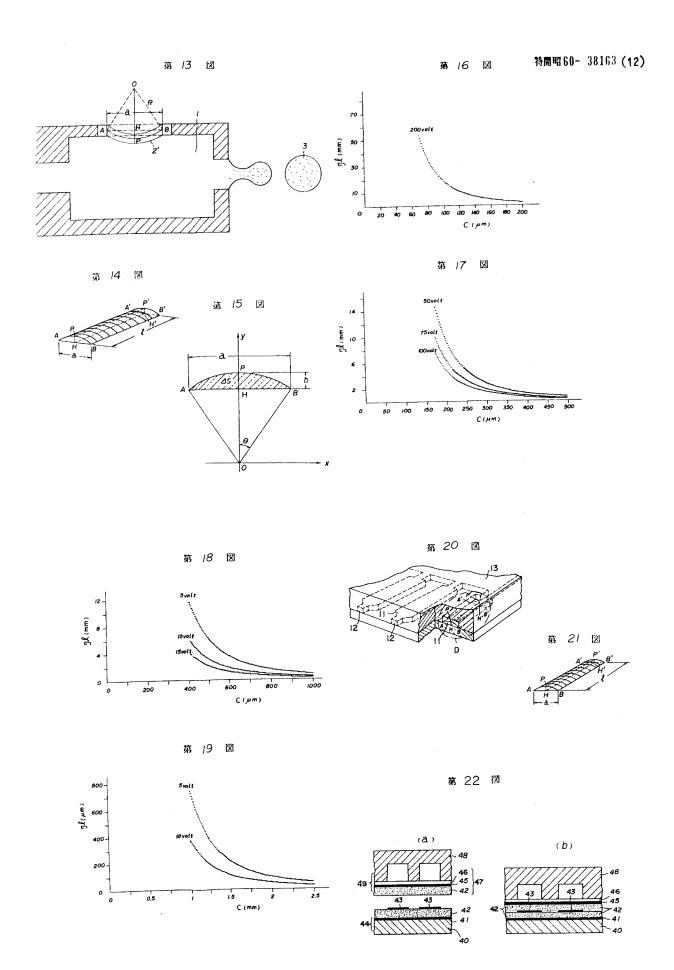
1 … インク窓、2 、2 、… 圧電性高分子、3 … インク滴、1 1 … インク加圧室、1 2 … インク噴射ノズル、1 3 … インク供給部、2 0 … 基板、2 1 … 導電層(E i)、2 2 … 圧電性高分子、2 3 … 導電層(E g)、2 4 … 保護層、2 5 … インクに路形成体、3 0 、4 0 … 基板、3 1 、4 2 、5 2 … 圧電性高分子、2 5 … インクに路形成体、3 0 、4 0 … 基板、3 1 、4 2 、5 4 … 導電層(E g)、3 2 、4 1 、4 5 、5 1 、5 4 … 導電層(E g)、3 3 、4 6 、5 5 … 保護層、3 7 、4 3 、5 8 … 導電層(E ;)、3 6 、4 8 、5 7 … インク流路形成体、6 1 … 排い支持基板部、6 2 … 一部分空洞部、6 3 … 全面空洞部。

特許出願人 株式会社リコー 代理人 高 野 明 近 (1987)

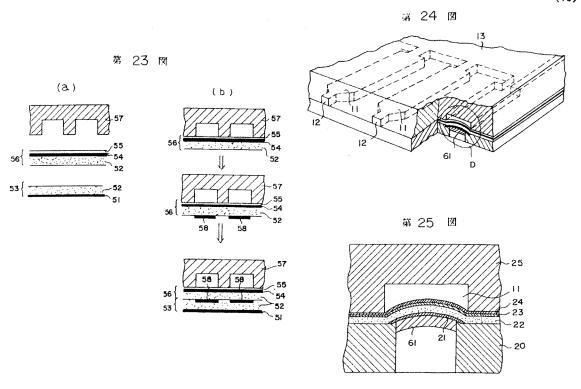


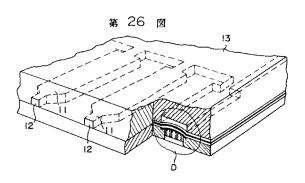
特開昭60- 38163 (11)

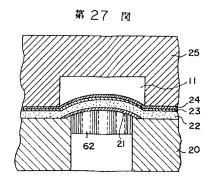




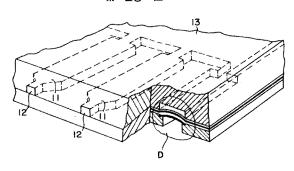
特開昭 60- 38163 (13)



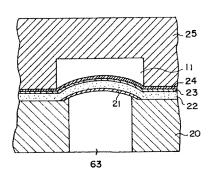




第 28 図



第 29 図



手統補正鬱(方式)

昭和58年12月12日

特許庁長官 若杉和夫殿

1.事件の表示

昭和58年 特許願 第146867号

2.発明の名称

インクジェットヘッド

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

オオタク ナカマゴメ

住 所 東京都大 田 区 中 馬 込 1丁目3番6号

氏 名(名称) (674) 株式会社 リコー 代表者 浜 田 広

4.代 理 人

住 所 〒231 横浜市中区不老町1-2-7

シヤトレーイン横浜807号

電話045(681)2139番

E 名 (7984) 弁理士 高 野 明 近

5.補正命令の日付

昭和58年11月29日

6.補正の対象

図面の簡単な説明の欄

7.補正の内容

明和書第35頁第5行目の「第29は、」を 「第29団は、」に補正する。

